

10/522504

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
12. Februar 2004 (12.02.2004)

PCT

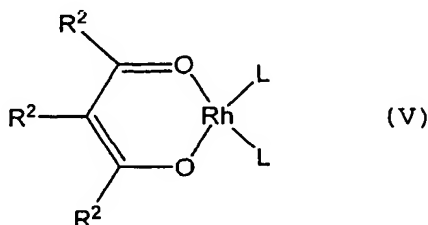
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
WO 2004/013230 A2

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: C08L 83/04, C08K 5/00, 5/56, A23G 3/02
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/008175
- (22) Internationales Anmeldedatum:  
24. Juli 2003 (24.07.2003)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:  
102 35 268.2 1. August 2002 (01.08.2002) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): WACKER-CHEMIE GMBH [DE/DE]; Hanns-Seidel-Platz 4, 81737 München (DE).
- (72) Erfinder; und  
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FEHN, Armin [DE/DE]; Unghausen 12 D, 84561 Mehring (DE). WEI-DINGER, Jürgen [DE/DE]; Gaussstrasse 9, 84489 Burghausen (DE). DÜRNBERGER, Adelheid [AT/AT]; Wiesing 5, A-5230 Mattighofen (AT).
- (74) Anwälte: GÖSSMANN, Christoph usw.; Wacker-Chemie GmbH, Zentralbereich PML, Hanns-Seidel-Platz 4, 81737 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).
- Veröffentlicht:  
— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: CROSS-LINKING SILICONE ELASTOMERS, METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF, AND USE OF THE CROSS-LINKABLE MASSES

(54) Bezeichnung: VERNETZENDE SILICONELASTOMERE, VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG SOWIE DIE VERWENDUNG DER VERNETZBAREN MASSES



radicals having between 1 and 24 carbon atoms, R<sup>3</sup> can be the same or different and represents hydrogen, -OR<sup>4</sup> or monovalent, optionally substituted hydrocarbon radicals having between 1 and 24 carbon atoms, R<sup>4</sup> can be the same or different and represents a hydrogen atom or a monovalent, optionally substituted hydrocarbon radical having between 1 and 20 carbon atoms, X can be the same or different and represents halogen or hydrogen, L can be the same or different and represents CO, acetyl acetate, 0,5 cyclooctadiene, 0,5 norbornadiene or P(R<sup>3</sup>)<sub>3</sub>, and S represents 2 or 3.

(57) Zusammenfassung: Organopolysiloxanmassen, die durch zumindest eine Rhodiumverbindung härten, enthaltend: (A) Verbindungen, die Reste mit aliphatischen Kohlenstoff-Kohlenstoff-Mehrfachbindungen aufweisen, (B) Organopolysiloxane mit Si-gebundenen Wasserstoffatomen oder anstelle von (A) und (B) (C) Organopolysiloxane, die SiC-gebundene Reste mit aliphatischen Kohlenstoff-Kohlenstoff-Mehrfachbindungen und Si-gebundene Wasserstoffatome aufweisen, und (D) Rhodiumkatalysator, wobei zumindest einer aus der Gruppe ausgewählt wird, die aus Verbindungen der Formel [(R<sup>2</sup>-C(=O)-O-)<sub>2</sub>Rh]<sub>2</sub> (III), L(X)Rh(PR<sup>3</sup>)<sub>3</sub>, (VI) oder Formel (V) besteht, wobei R<sup>2</sup> gleich oder verschieden sein kann und Wasserstoffatom, oder einwertige, gegebenenfalls substituierte Kohlenwasserstoffreste mit 1 bis 24 Kohlenstoffatomen bedeutet, R<sup>3</sup> gleich oder verschieden sein kann und Wasserstoff, -OR<sup>4</sup> oder einwertige, gegebenenfalls substituierte Kohlenwasserstoffreste mit 1 bis 24 Kohlenstoffatomen bedeutet, R<sup>4</sup> gleich oder verschieden sein kann und Wasserstoffatom, oder ein einwertiger gegebenenfalls substituierte Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen ist, X gleich oder verschieden sein kann und Halogen oder Wasserstoff ist, L gleich oder verschieden sein kann und CO, Acetylacetonat, 0,5 Cyclooctadien, 0,5 Norbornadien oder P(R<sup>3</sup>)<sub>3</sub> ist und S 2 oder 3 ist.

WO 2004/013230 A2

10/522502

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
19. Februar 2004 (19.02.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2004/015773 A2**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **H01L 23/58**

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/002544

(22) Internationales Anmeldedatum:  
29. Juli 2003 (29.07.2003)

(25) Elnreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
102 34 648.8 29. Juli 2002 (29.07.2002) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von  
US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-  
Martin-Str. 53, 81669 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): ERTLE, Werner  
[DE/DE]; Pfarrer-Sickinger-Weg 128, 85579 Neubiberg

(DE). GOLLER, Bernd [DE/DE]; Bahnhofstr. 28 r,  
83624 Otterfing (DE). HORN, Michael [DE/DE]; St.  
Magnusstr. 2, 81545 München (DE). KOTHE, Bernd  
[DE/DE]; Zugspitzstr. 40, 85560 Ebersberg (DE).

(74) Anwalt: SCHWEIGER, Martin; Schweiger & Partner,  
Karl-Theodor-Str. 69, 80803 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, KR, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,  
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,  
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

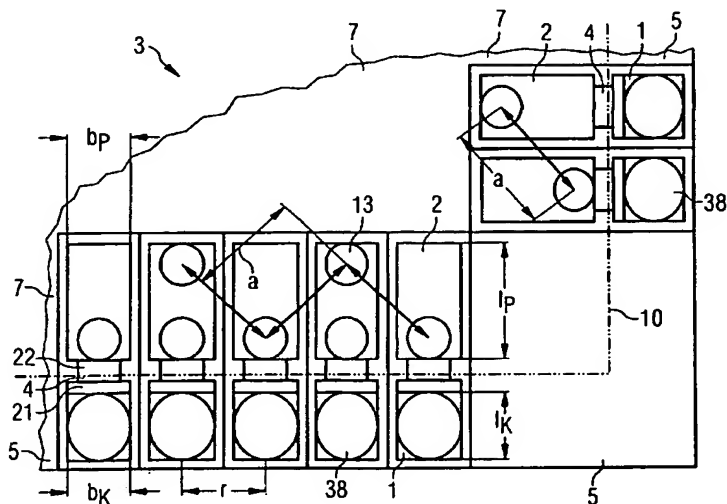
**Veröffentlicht:**

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu ver-  
öffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-  
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-  
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der  
PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: SEMICONDUCTOR WAFER HAVING ELECTRICALLY CONNECTED CONTACT AND TESTING SURFACES

(54) Bezeichnung: HALBLEITERWAFER MIT ELEKTRISCH VERBUNDENEN KONTAKT- UND PRÜFFLÄCHEN



(57) Abstract: The invention relates to an arrangement of contact surfaces (1) and testing surfaces (2) on a structured semiconductor chip (3). The contact surfaces (1) and testing surfaces (2) are electrically connected to one another via a conducting web (4). While the contact surfaces (1) are arranged in a first area (5) that does not contain any components of an integrated circuit, the testing surfaces (2) are located in a second area (7) of the upper side of the semiconductor chip (3) that contains components (6) of an integrated circuit.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2004/015773 A2